News Release/Presseinformation

Einzigartige Erfolgsgeschichte der CoolMOS™-Technologie: Infineon führt ersten 650-Volt-MOSFET mit integrierter Fast-Body-Diode ein und erhöht mit jetzt über 3,5 Milliarden Hochvolt-Transistoren die Energieeffizienz weltweit

Neubiberg, 7. Februar 2011 – Am 19. Januar 2011 verließ der 3,5 Milliardste CoolMOS™-Hochvolt-MOSFET die Produktionslinie im Werk von Infineon in Villach/Österreich. Infineon ist damit der weltweit erfolgreichste Anbieter für diese Transistoren für Spannungen von 500 bis 900 Volt. Basis des Erfolges ist die kontinuierliche Verbesserung der Architektur, um die CoolMOS™-Transistoren technologisch ständig weiter zu perfektionieren.

55 Jahre nach der Erfindung des Transistors hatte Infineon im Jahre 2002 den Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft für seine revolutionäre CoolMOS™-Transistor-Technologie erhalten. Die Hochvolt-Leistungstransistoren erhöhen die Energieeffizienz in vielen unterschiedlichen Anwendungen wie PC-Netzteilen, Servern, Solar-Wechselrichtern, Beleuchtungssystemen und Telekommunikations-Anlagen. Aber auch aus Geräten der Unterhaltungsektronik wie Flachbild-Fernsehern und Spielekonsolen sind diese Energiesparchips nicht mehr wegzudenken. Energieeffizienz und Energieeinsparung entwickeln sich zu den wichtigsten Anforderungen für alle Anwendungen in Industrie und Haushalt, die elektrische Energie verbrauchen. Mit den energieeffizienten Halbleiterlösungen von Infineon können bis zu 25 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs eingespart werden. Ein Server-Board beispielsweise verbraucht dank CoolMOS™-Chips rund 30 Watt weniger Strom. Hochgerechnet auf alle weltweit eingesetzten rund 60 Millionen Server, entspräche dies einer Ersparnis von 1,8 Gigawatt, der Leistung eines Atomkraftwerks.

„Wir haben die Technologie des CoolMOS™-Transistors kontinuierlich weiterentwickelt um die Effizienz zu maximieren und unseren Kunden klare Wettbewerbsvorteile zu bieten. Wir liefern einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Schonung der Ressourcen für zukünftige Generationen“, sagte Andreas Urschitz, Vice President & General Manager Power Management and Supply Discretes bei Infineon Technologies. „Ein schönes Beispiel für den erfolgreichen

Für die Wirtschafts- und Fachpresse
Informationsnummer INFIMM201102.021d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Christian Hoenicke
Tel.: +49 89 234-25869
christian.hoenicke@infineon.com

Investor Relations:
Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com

www.BDTIC.com/infineon

Einsatz unserer CoolMOS™-Technologie ist die Solaranlage für das Fußball-Stadion in Kaohsiung/Taiwan. Hier sorgen CoolMOS™-Chips in den Solarwechselrichtern für höchstmögliche Energieeffizienz. Damit erzeugt die Solaranlage 1,1 Millionen Kilowattstunden Strom und spart rund 660 Tonnen CO_2 im Jahr."

Nächster Technologiesprung ist der neue 650V CoolMOS™ CFD2

Jetzt bringt Infineon mit der nächsten Generation der Hochvolt-CoolMOS™-MOSFETs eine weitere Innovation auf den Markt: der neue 650V CoolMOS™ CFD2 ist der weltweit erste Hochvolt-Transistor mit 650 Volt Ausfallspannung und einer integrierten Fast-Body-Diode. Die bessere Kommutierungseigenschaft und das daraus resultierende optimierte EMI-Verhalten sind klare Wettbewerbsvorteile des Produkts. Das Portfolio bietet alle Vorteile der schnell schaltenden Superjunction MOSFETs wie ein höherer Wirkungsgrad bei geringer Last, einfache Handhabung und herausragende Zuverlässigkeit. Infineon sieht das größte Marktpotenzial für diesen Transistor in Anwendungen für Solar-Wechselrichter, Server, LED-Beleuchtungen und im Bereich Telekommunikation.
Weitere Informationen zur neuen CFD2-Produktfamilie unter www.infineon.com/cfd2

Die CoolMOS™-Technologie von Infineon

Die Leistungs-MOSFETs der CoolMOS™-Familie von Infineon setzen weltweit unerreichte Maßstäbe in punkto Energieeffizienz. Im Bereich Hochvolt-MOSFETs sorgen die CoolMOS™-Bausteine für eine maßgebliche Verringerung der Leitungs- und Schaltverluste. Gleichzeitig gewährleisten sie eine hohe Leistungsdichte und Effizienz und ermöglichen damit erstklassige Stromwandler-Systeme. Insbesondere die jüngste, hochmoderne Generation von Infineon Hochvolt-MOSFETs ermöglicht AC/DC-Stromversorgungen, die noch effizienter, kompakter und leichter sind und dabei weniger Wärme produzieren. Ausschlaggebend hierfür ist, dass die CoolMOS™-Bausteine von allen auf dem Markt verfügbaren Hochvolt-MOSFETs den geringsten Widerstand im Einschaltzustand pro Gehäusefläche und die höchste Schaltgeschwindigkeit bieten. Zudem stellen sie die geringsten Anforderungen an die Ansteuerung in diesem Bereich. Weitere Informationen zu den CoolMOS™-Produkten von Infineon unter www.infineon.com/CoolMOS

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.650 Mitarbeiterinnen

Für die Fachpresse
Informationsnummer INFIMM201101.021d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Christian Hoenicke
Tel.: +49 89 234-25869
christian.hoenicke@infineon.com

Investor Relations:
Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com

www.BDTIC.com/infineon

und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2010 (Ende September) einen Umsatz von 3,295 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com
Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse

BDTIC

Für die Fachpresse
Informationsnummer INFIMM201101.021d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Christian Hoenicke
Tel.: +49 89 234-25869
christian.hoenicke@infineon.com

Investor Relations:

Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com

www.BDTIC.com/infineon